

めっきプロセス

長年表面処理薬剤の開発と同時に、めっきプロセスの開発も行ってまいりました。

その間にも様々な材料・新素材が出現し、それぞれの材料に要求される特性もいろいろございます。

新しい分野への進出をご希望されている方、新しいお客様を開拓されようとする方、ご参考になれば幸いです。

- シリコンウエハー（半導体）上の無電解Ni-Auめっきプロセス（電極形成）
- Nd-B-Fe（ネオジム磁石）上のNiめっきプロセス
- 高周波誘電体フィルターへのめっきによる電極形成
- PZT上のめっきによる電極形成
- Cu-W上のめっき法（オール無電解Ni法）
- ハーメチックシール（気密端子、水晶振動子）上の無電解Ni-Auめっき法
- Al_2O_3 、 AlN 上のWペースト上のNi-Auめっき法（セラミックICパッケージ）
- Ag-Pd、Agペースト印刷パターン上のNi-Au選択部分めっき法（LTCC基板）
- Ag、Ag-Pdペースト電極上の電解Ni-電解はんだめっき法（CR、チップコンデンサー）
- Ag-Cuロウ上の無電解めっき法（コバール-Ag-Cuロウ）
- 異種金属上（PGA）上のNi-Au-Auめっき法（セラミックICパッケージ、W/B-Au）
- 半導体電極上のNi-はんだバンプに関するめっき法
- セラミックス、ガラス上 Al 薄膜上の選択部分めっき法Ni-Au（CAT-92）
- 半導体チップ上の薄型バンプ（CAT-920-UBM）
- Cu系リードフレーム上の無電解Niめっき法
- PCB、Cu配線パターン上の選択部分Ni-Auめっき法（CAT-2000）
- Cr-Cu薄膜ファインパターン上の選択Ni-Auめっき法（CAT-99）
- SLC、ビルドアップ基板上の選択部分Ni-Auめっき法、BGA対応（CAT-900）
- ダブルニッケルめっき法（二重ニッケルめっき）、高耐食性
- フープ（ストリップ、鋼帯）上の電気めっきプロセス
- ステンレス、超硬（SKD）等上のめっきプロセス
- 繊維、テキスタイル、発泡性樹脂上の化学めっき法
- プラスチック上のめっきプロセス（プラめっき）
- 微粉上（ Al_2O_3 、 SiO_2 、マイカ、ダイヤモンド）の無電解めっき法
- ガラス金型上のめっき方法
- TiおよびTi合金上の各種めっきのための下地めっき法
- ダイヤモンドの共析めっき（半導体ダイシングソウ、ドリル）
- PTFE共析めっき
- 潤滑めっき法（共析めっきとは異なる）
- Al 部材上のめっきプロセス
- WPCプロセス（スルーホールめっきプロセス）
- TICOMAC法（セラミックス上のCu配線パターン）
- セラミックスコンデンサー上のめっきによる電極形成方法
- WMFプロセス（無電解めっき液の自社建浴法）
- CAT-2000、2000-1、PCB用ファインパターン上のNi-P/F-Au
- トリビーマルチ-1、トリビーマルチ-2、トライボロジー、高潤滑性多層めっき法
- Znダイキャスト用めっきプロセス
- NBF-プロセス、高耐食、電気めっき法（焼結体）

めっき設備・排水処理設備・めっき液自動管理装置・プリント基板用めっき設備

- 弊社独自のめっき手法をめっき装置に組み込み、他社がまね出来ない装置を多数納入いたしております。

共同研究・委託研究・プロセス開発

- 有償で委託させて頂いております。

試作加工（有償）

- 少量多品種のめっき加工を承っております。

金・貴金属の回収、リサイクル事業

- Au、Pt、Ag、Pd、Rh

※詳しくは、営業マンにお問合わせください。